

СТМ исследования поведения адатомов Ge на поверхности Si(111)-5,55×5,55-Cu / Д.Н. Чубенко, А.В. Кириллов, И.В. Гвоздь, Д.В. Грузнев, А.В. Зотов, А.А. Саранин // Материалы XII-й межрегиональной конференции молодых ученых по физике полупроводниковых, диэлектрических и магнитных материалов «ПДММ'2009». Владивосток, ИАПУ ДВО РАН, 17-20 июня 2009 г. – Владивосток: изд-во «Дальнаука», 2009. – С. 46-50.